

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2024]12 号

## 关于召开《半导体单晶材料透过率测试方法》等 10 项半导体材料标准 工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2024 年标委会工作安排，现定于 2024 年 6 月 4 日~6 日在湖北省武汉市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

### 一、会议内容和资料

会议将对《半导体单晶材料透过率测试方法》等 10 项半导体材料标准进行预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 5 月 27 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 5 月 31 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

### 二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2024 年 6 月 4 日全天。

2、报到地点：武汉四季鑫宝来酒店（武汉市雄楚大道 87 号，电话：027-50759999）。

3、乘车路线：①武汉天河机场：乘地铁 2 号线到螃蟹岬站 D1 口出站，步行 395 米至友谊大道沙湖站，乘 777 路至雄楚大道 BRT 静安路站，步行 100 米到酒店；乘出租车到酒店大约 42 公里，打车约 120 元；②武汉东站：武汉东站西广场（BRT）站乘 BRT1 路至雄楚大道 BRT 静安路站，步行 100 米到酒店；乘出租车到酒店大约 13 公里，打车约 30 元；③武昌火车站：武汉火车站东广场（BRT）站乘 BRT1 路至雄楚大道 BRT 静安路站，步行 100 米到酒店；乘出租车到酒店大约 3 公里，打车约 10 元；④武汉站：乘地铁 4 号线至武昌火车站下，步行 350 米至武昌火车站公交场站乘 908 路至雄楚大道 BRT 静安路站，步行 100 米到酒店；乘出租车到酒店大约 19 公里，打车约 40 元。

### 三、会务及联系人

本次会议由武汉拓材科技有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

会议会务：季佳硕 13521167446。

### 四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2024 年 5 月 27 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，5 月 27 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：6 月武汉半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议预审和讨论的标准项目

二〇二四年五月六日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会





附件：

会议预审和讨论的标准项目

| 序号 | 组别  | 计划文号及编号                            | 项目名称                                       | 牵头单位              | 备注 |
|----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----|
| 1  | 第一组 | 国标委发[2023]58 号<br>20231111-T-469   | 半导体单晶材料透过率测试方法                             | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
| 2  |     | 国标委发[2023]58 号<br>20231107-T-469   | 硅片氧沉淀特性的测试 间隙氧含量减少法                        | 麦斯克电子材料股份有限公司     | 讨论 |
| 3  |     | 国标委发[2023]64 号<br>20233951-T-610   | 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法                     | 有研国晶辉新材料有限公司      | 讨论 |
| 4  |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-039-T/CNIA | 半导体洁净室 空气分子污染物（AMC）掺杂剂 B 和 P 测定电感耦合等离子体质谱法 | 天津中环半导体股份有限公司     | 预审 |
| 5  |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-040-T/CNIA | 半导体洁净室 水溶性空气分子污染物（AMC）的测定 离子色谱法            | 天津中环半导体股份有限公司     | 预审 |
| 6  | 第二组 | 国标委发[2023]58 号<br>20231115-T-469   | LED 外延芯片用砷化镓衬底                             | 大庆溢泰半导体材料有限公司     | 预审 |
| 7  |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-035-T/CNIA | 质量分级及“领跑者”评价要求高纯二氧化锗                       | 昆明冶金研究院有限公司       | 预审 |
| 8  |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-037-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范高纯二氧化锗                         | 云南驰宏国际锗业有限公司      | 预审 |
| 9  |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-038-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范锗单晶和锗单晶片                       | 云南驰宏国际锗业有限公司      | 预审 |
| 10 |     | 中色协科字[2023]95 号<br>2023-041-T/CNIA | 蓝宝石晶体生长隔热用氧化锆纤维屏                           | 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 | 预审 |